

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

【発行日】平成20年4月24日(2008.4.24)

【公開番号】特開2006-241520(P2006-241520A)

【公開日】平成18年9月14日(2006.9.14)

【年通号数】公開・登録公報2006-036

【出願番号】特願2005-59081(P2005-59081)

【国際特許分類】

C 2 3 C 16/455 (2006.01)

C 2 3 C 16/34 (2006.01)

H 0 1 L 21/28 (2006.01)

H 0 1 L 21/285 (2006.01)

H 0 1 L 21/3205 (2006.01)

H 0 1 L 23/52 (2006.01)

【F I】

C 2 3 C 16/455

C 2 3 C 16/34

H 0 1 L 21/28 3 0 1 R

H 0 1 L 21/285 C

H 0 1 L 21/88 R

【手続補正書】

【提出日】平成20年2月28日(2008.2.28)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 4 9

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 4 9】

真空チャンバ11の上方で、基板ホルダー13に対向する位置にターゲット18が設置されている。ターゲット18には、その表面をスパッタリングし、ターゲット構成物質の粒子を放出させるプラズマを発生させるための電圧印加装置19が接続されている。なお、ターゲット18は、上記原料ガスに含まれる金属の構成元素(Ta)を主成分とするもので構成されている。この電圧印加装置19は、直流電圧発生装置191と、ターゲット18に接続された電極192とから構成されている。この電圧印加装置は、直流電圧発生装置191の代わりに、直流に交流を重畠させたものを有していてもよい。また、基板ホルダーに高周波発生装置が接続されていて、バイアスが印加できるような形でもよい。

【手続補正2】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【図4】

